

مجلهٔ پژوهش فیزیک ایران، جلد ۲۴، شمارهٔ ۴، زمستان ۱۴۰۳ DOI: 10.47176/ijpr.24.4.41878

مطالعهٔ رابطهٔ تارشدگی تصویر و عمق تولید فوتونهای نوری با استفاده از پرتو ایکس کیلوولتاژ و سوسوزنهای میکروستونی به کمک کد مونت کارلوی جیانت ۴

حسین معینی^۱* و مجتبی مکاری^۲ ۱. بخش فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه شیراز، شیراز ۲. گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان

*پست الكترونيكي: h.moeini@shirazu.ac.ir

(دریافت مقاله: ۱۴۰۳/۱/۱۷ ؛ دریافت نسخهٔ نهایی: ۱۴۰۳/۸/۱)

چکیدہ

آشکارسازهای پرتو ایکس، با بازده آشکارسازی و قدرت تفکیک مکانی بسیار خوب، کاربردهای متنوعی از جمله در پرتونگاری و تحقیقات پایه دارند. بسیاری از روشهای پرتونگاری موجود عموماً از بازده مناسبی برخوردار نبوده و زمانبر هستند و برای کاربردهایی که مستلزم اندازه گیری در لحظهاند مناسب نیستند. یکی از راه حلهای پیشنهاد شده برای اجتناب از این معضل توسعهٔ فیلمهای سوسوزن ساختاریافته همچون یدید سزیم بوده است که چگالی بالا و پاسخ سریع آنها میتواند راهگشا باشد و در عین حال امکان رشد آنها با ابعاد میکرومتری و تراکم زیاد بهبود کیفیت تصویر را به همراه خواهد داشت. در این مطالعهٔ شبیهسازی، با استفاده از جعبهابزار جیانت ۴ و بهره گیری از یک هندسهٔ ساده شامل یک صفحهٔ پلیمر در نقش دوربین برای ثبت فوتونهای نوری، یک مجموعهٔ ساختارمند از سوسوزنهای با ابعاد میکرومتری در نقش مبدل پرتو ایکس، و یک صفحهٔ آلومینیوم در نقش انعکاس دهندهٔ نور برای کاهش افت بازده فوتونها، وابستگی تارشدگی تصویر به عمق تولید فوتونهای نوری را برای باریکههای نوکمادادی پرتو ایکس بررسی کردهایم.

واژههای کلیدی: تارشدگی تصویر، پرتو ایکس کیلوولتاژ، سوسوزن میکروستونی، فوتونهای نوری، کد مونت کارلوی جیانت ۴

۱. مقدمه

با کشف پرتو ایکس توسط ویلهلم رونتگن و معرفی تصویربرداری پرتو ایکس در اواخر قرن ۱۹ میلادی، پیشرفت در این زمینه از جمله در برشنگاری^۱ سهبعدی و استفاده از فناوریهای مدرن در صنعت و پزشکی سرعت بسیار زیادی داشته است. برشنگاری یک ابزار قدرتمند برای بررسی اجسام

بزرگتر از اندازه های طول موج پرتوهای ایکس است و برای بازسازی مدل های سه بعدی اشیاء کاربرد دارد. تصویر برداری پرتوی و برشنگاری، لنواع مختلفی از تصویر برداری و برشنگاری از جمله تصویر برداری و برشنگاری پرتو ایکس، پروتون، نوترون، میون و غیره را در برمی گیرد. پرتو ایکس، یکی از پرکار بردترین پرتوها در تصویر برداری تشخیصی

1. Tomography

مجموعهای ساختارمند از سوسوزنهای استوانهای شکل با ابعاد میکرومتری به منظور بهبود بازده نور دریافتی توسط صفحه دوربين است، تغييرات تارشدگي " تصوير نقش بسته بر لایهٔ پلیمر (دوربین) را بر حسب عمق های مختلف تولید نور مرئی (به واسطهٔ پدیده های سوسوزنی و چرنکوف) با معیار تابع LSF ⁴ تحقیق میکنیم. همچنین از درصدی از تعداد فوتون های تولید شده داخل استوانهٔ مرکزی (که در حالت آرمانی بیشــترین تأثیر را از پرتو ایکس نوکمدادی اعمال شده بر هندسه دریافت می کند) براوردی ارائه خواهیم کرد که در انتهای همان استوانه بر سطح صفحهٔ دوربین فرود می آیند. برای مقایسیه، از لحاظ نظری برای یک سےاختار استوانهای کاملاً موازی قرار گرفته در خلاً و از جنس فسفر شفاف، تنها ١٧٪ از نور توليد شده داخل آن موفق به رسيدن به وجههای دایرهای آن شده و بقیهٔ فوتونهای تولید شده به واسطهٔ انکسار نور از سطح جانبی استوانه نشت کرده و با تحت تأثير قرار دادن استوانه های مجاور منجر به پهن شدگی س_یگنال خواهند شـد [۱۳]. کیفیت نهایی تصـویر در یک سامانهٔ تصویربرداری دیجیتال متأثر از ویژگی های انتقال سیگنال و نوفهٔ صفحهٔ سوسوزن است و این موضوع از دههٔ ۶۰ میلادی شناخته شده بود که انتقال نور بر میزان حساسیت و تابع انتقال مدولاسیون^۵ امولسیونهای تصویربرداری اثر گذار است [۱۴]. استفاده از صفحات ساختارمند سوسوزن تلاشى است براى افزايش بهبود كيفيت تصوير با به مخاطره انداختن نسبى بازده جذب حداكثري پرتو ايكس به واسطهٔ جایگزینی قسمتی از هندسهٔ سوسوزن همگن با ميكر وستونها.

۲. مواد و روشها

این مطالعه بر پایهٔ شبیهسازی مونتکارلو و با استفاده از جعبهابزار

- ۳. Blurring
- ۴. Line Spread Function
- ۵. Modulation Transfer Function

پزشکی است که با توجه به عمق نفوذ زیاد در داخل بدن، اطلاعات مفیدی را جهت تشخیص و درمان ارائه می کند. تصاویر تهیه شده از پرتو ایکس، که ماحصل برهمکنش فوتونهای پرانرژی با ماده هستند، ارائه دهندهٔ ضریب جذب پرتو ایکس در ماده هستند که به ترکیبات شیمیایی و وضعیت فیزیکی ماده وابسته است. پرتو ایکس در تصویربرداری صنعتی و کلینیکی بسیار مفید است و تقریباً همهٔ ما تاکنون تکنیکهای تصویربرداری پزشکی با پرتو ایکس انجام دادهایم. تکنیکهای تصویربرداری با پرتو ایکس به این دلیل که بافتها وضوح پرتوی مناسبی دارند، تاکنون جوابگو بودهاند. به عنوان مئال، استخوانها درصد زیادی از پرتوهای ایکس را جذب وضوح، قابل مشاهده هستند و همچنین ریههای پر از مایع یک بیمار پرتوهای ایکس را بیشتر از ریههای پر از هوا به وضوح نشان میدهند [1–۳].

جهت بررسی و ترابرد میزان نور تولید شده توسط پرتو یونیزان همچون پرتو ایکس می توان از مجموعهای از کدهای شبیه سازی که عموماً بر اساس روش مونت کارلو کار می کنند، استفاده کرد. در این خصوص می توان به کدهای (۲) و DETECT2000 [۵]، ValoMC [۶]، جیانت ۴ سبیه سازی که منحصراً به بررسی اثرات فیزیکی و شیمیایی شبیه سازی که منحصراً به بررسی اثرات فیزیکی و شیمیایی پرتوهای یونیزان (بدون لحاظ کردن ترابرد نور که در کاربردهای تصویربرداری اهمیت دارد) پرداختهاند می توان به کاربردهای معینی و همکاران [۹و ۱۰] و مکاری و همکاران با (۱۲] اشاره کرد. در این پژوهش، با استفاده از کد جیانت ۴ و شبیه سازی برهمکنش باریکه های نوکمدادی^۲ پرتو ایکس با

۱. Geant4

۲. Pencil Beam



شکل ۱. نمایی از هندسهٔ شبیهسازی که شامل لایههایی از جنس آلومینیوم (Al)، سوسوزنهای یدید سزیم (Homogeneus & Microcolumnar)، و پلیکلروسترین (Polymer) در راستای تابش پرتو ایکس (از سمت راست به چپ) است. در این شکل، پرتو ایکس به صورت پرتو با رنگ زرد نشان داده شده و فوتونهای نوری پرتوهای نشان داده شده به رنگ سبز هستند.

میکروستونی، فیبرهای چگالی از سوسوزنهای یدید سزیم هستند که حاصل رشد بر روی یک زیرلایه با طراحی مشخص هستند [۱۵]. سوسوزنهای یدید سزیم پرتو ایکس فرودی را با بازده تبدیل بسیار بالای ۶۴ هزار فوتون نوری بر واحد MeV تبديل به نور مرئي ميكنند [۱۶]. لايهٔ آخر (سمت چپ شکل ۱) نیز که نقش صفحهٔ دوربین را دارد و در اینجا با عنوان لايهٔ پليمر ذكر مي شود از جنس پلي كلروسترين ' در نظر گرفته شده است (C₈H₇Cl) ضخامت لایههای فوق (در راستای محور z که همان راستای تابش پرتو ایکس اولیه است) به ترتیب برابر با ۵، ۲۰، ۸۰، و µm ۱۰ در نظر گرفته شده است. هر كدام از ميكروستون ها قطر ۹ و ضخامت (يا طول) μm ۸۰ دارند و آرایهٔ طراحی شده شامل ۵۰۱×۵۰۱ عدد میکروستون است که در آن فاصلهٔ هر دو استوانهٔ مجاور در راستای x و y برابر با ۱۰ µm است و فضای بین آنها با هوا پر شده است. چگالی مادهٔ یدید سزیم برابر با ۴/۵۱g/cm و کسر جرمی سزیم و ید آن برابر با ۵۱۱۵۴۹ و ۴۸۸۴۵۱ • در نظر گرفته شده است. در شبیه سازی حاضر، برای مادهٔ سوسوزن دو ثابت زمان واپاشی ۶۷۹ و ۳۳۴۰ نانوثانیه در قالب SCINTILLATIONTIMECONSTANT لحاظ شدهاند و بازدههای سوسوزنی متناظر برابر با ۶۳۷/۰ و ۳۶۳/۰ در نظر گرفته

Geant4-11.0.1 صورت گرفته است که در آن از کلاس G4EmStandardPhysics_option4 و مدل مرجع FTFP_BERT كه شامل همهٔ فرايندهای الكترومغناطيس استاندارد بوده و برای انرژیهای کمتر از GeV توصیه شده استفاده کردهایم. همچنین، از مدلهای تعریف شده در کلاس G4OpticalPhysics که مناسب فرایندهای اپتیکی مربوط به ترابرد فوتون نوری هستند استفاده شده است [۷]. در این شبیهسازی تعداد یک میلیون پرتو ایکس (به ازای هر یک از مقادیر انرژی اولیهٔ ۵ تا ۵۰ keV) با رخنمای نوکمدادی استفاده شده است که مطابق شکل ۱ از سمت راست بر هندسهٔ مفروض تابانده شدهاند. این شکل، هندسهٔ مورد استفاده در این شبیهسازی را نشان میدهد که شامل یک لایهٔ پوششی (سمت راست شکل ۱) از جنس الومینیوم است که پرتو ایکس اولیه در بدو ورود به هندسه از آن می گذرد و نقش این لایه بازتاب فوتون های نوری تولید شده در داخل مادهٔ سوسوزن به درون هندسه است و به منظور افزایش بازده نوری به کار میرود. لایههای دوم و سوم به ترتیب یک قطعهٔ همگن و آرایهای مربعی از سوسوزنهای استوانهای شکل با ابعاد میکرومتری است که همگی از جنس یدید سزیم در نظر گرفته شده و نقش مبدل پرتو ایکس را دارند. این ساختارهای



شکل ۲. نمودار LSF به ازای انرژیهای پرتو ایکس ۵ تا ۵۰ «۵۰.

شدهاند. ضریب شکست مادهٔ سوسوزن و پلیمر به ترتیب برابر با ۸/۱ و ۱/۶۳۹ در نظر گرفته شده است. همچنین، برای فرایندهای اپتیکی، در محل سطح، مدل UNIFIED استفاده شده است و مشخصات اپتیکی مواد شامل ضریب بازتاب از سطح (REFLECTIVITY) و انتقال از طریق فصل مشترک دو محیط (ABSLENGTH) و نیز طول جذب (TRANSMITTANCE) لحاظ شدهاند که برای هوا، یدید سزیم، و پلیکلروسترین به ترتیب برابر با مقادیر ۱۰۰، ۱ و ۱ میلیمتر در نظر گرفته شده است.

۳. بحث و بررسی نتایج

شکل ۲ تعداد فوتون های نوری فرود آمده بر سطح لایهٔ پلیمر بر حسب مختصات x آنها را نشان می دهد که در ادامه از آن به عنوان LSF یاد شده و در ساختارسنجی تصویربرداری^۱ معیاری است از توزیع خطی میزان تابش دریافت شده توسط دوربین [۱۷]. این نتایج مربوط به پرتوهای ایکس با انرژی اولیهٔ ۵، ۱۰، ۲۰، ۴۰ و keV ۵۰ است و توسط فوتون هایی تشکیل شده که از داخل هوا یا میکروستون ها به سطح این لایه رسیدهاند. الگوی نوسانی مشاهده شده انعکاسی از فاصلهٔ ۱۰ میکرومتری میکروستون ها از یکدیگر است. نقاط کمینهٔ موضعی این هیستوگرام ها آمار غیر صفر دارند. علت آن

فوتون های نوریاند که علی رغم این که عموماً داخل مادهٔ سوسوزن (از جمله داخل میکروستون،ها) تولید شدهاند ولی ترابرد نهایی آنها تا صفحهٔ پلیمر از داخل میکروستونها صورت نپذیرفته است بلکه این فوتونها از فضای خالی بین میکروستون،ها که حاوی هوا در نظر گرفته شده به صفحهٔ پلیمر رسیدهاند. نتایج این شکل نشان میدهد که افزایش انرژی پرتو ایکس بازده نوری بیشتری در صفحهٔ پلیمر به همراه خواهد داشت. در قیاس با مقادیر پایین تر انرژی پرتو ایکس، نتایج انرژی های ۴۰ و keV نزدیک به یکدیگر است؛ هر چند نتایج انرژی keV از پهن شدگی کمتری برخوردار است که بیانگر وضوح نسبی بهتر تصویر حاصل است. برای براورد حداکثر خطای آماری در بازسازی هیستوگرامهای شکل ۲، نمودار مربوط به انرژی ۵ کیلوالکترون ولت را که به واسطهٔ آمار کمتر از خطای آماری بیشتری نسبت به نمودارهای دیگر برخوردار است در نظر می گیریم. با توجه به این که حداقل آمار ثبت شده روی محور x واقع در محدودهٔ ۱/۰- تا ۱/۰ میلی متر حدود ۳۰۰۰ فوتون است (در فاصلهٔ حدود ۹۵ ۰/۰ میلیمتری از محور z روی صفحهٔ پلیمر)، خطای آماری مربوطه در حدود ۱/۸ درصد به دست می آید. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که خطای آماری مربوط به نمودار LSF مربوط به مقادیر انرژی پرتو ایکس بزرگتر از ۵ کیلوالکترون ولت نیز در هر موقعیت نوعی بین ۱/۰- تا ۱/۰ میلیمتر روی محور x کوچکتر از ۱/۸ درصد خواهد بود.

شکل ۳ نتایج LSF را برای انرژی keV ۵۰ نشان می دهد که در آن مختصات z فوتونهای نوری، در ابتدای تولید آنها داخل مادهٔ سوسوزن (شامل قطعهٔ همگن و میکروستونها)، برابر با مقادیر مختلف ذکر شده در شکل در بازهای یک میکرومتری انتخاب شده است. به عنوان مثال، نمودار مربوط به انتخاب تدلیه است. به عنوان مثال، نمودار مربوط به مع مواد عربوط به واسطهٔ فوتونهایی که مختصات z نقطهٔ تولید آنها داخل مادهٔ سوسوزن فاصلهای بین ۹۹ و سس ۱۰۰ از فصل مشترک بین لایهٔ آلومینیومی و لایهٔ همگن سوسوزن داشته باشد رسم کرده است. لازم به ذکر است

^{1.} Photographic Structurometry



شکل ۳. نمودار LSF کل برای انرژی پرتو ایکس ۵۰ keV (نمودار مشکی رنگ). سایر نمودارها که انتگرال هر کدام با انتگرال LSF کل برابر است (برای تمام فوتونهایی که از مختصات x و y واقع در بازهٔ ۵۰/۵۰ تا ۲۵ mm ۲۵/۰ از صفحهٔ پلیمر عبور کردهاند)، سهم نسبی فوتونهای تولید شده در بازهٔ ضخامتی [zvertex, zvertex + 1 µm] را در بازسازی وضوح نهایی تصویر (LSF کل) نشان میدهند. نمودارهای این شکل مختصات x را در بازهٔ ۲۰۰۰ تا ۱۳m /۱۰ نشان میدهند.

حداقلی و بازتاب بهینهٔ این فوتونها در کل فرایند ترابرد آنها تا صفحهٔ دوربین است. همچنین، وضوح تصویر حاصل از فوتونهای نوری با $m \, a \, a \, a$ تابل قیاس با وضوح تصویر حاصل از همه فوتونهای ثبت شده در صفحهٔ دوربین است. شکل ۴ (نمودار نقطه چین) توزیع فاصله تا محور z را برای نقاط فرود فوتونهای نوری بر سطح لایهٔ پلیمر نشان می دهد که در آن x و y میزان انحراف طولی و عرضی فوتون نوری از امتداد اولیهٔ پرتو ایکس keV است. قلهٔ مطلق این نمودار در مقداری غیر از 0 = r واقع شده که علت آن به واسطهٔ برایند تمام فرایندهای فیزیکی (از جمله پراکندگی چندگانهٔ کولنی الکترونهای ثانویه و نیز بازتاب و جذب فوتونها) است که باعث می شود آمار فوتونهایی که به فصل که بهنجارش همهٔ توابع برچسب زده شده با ۰ تا μ۹۹ (به صورت شرح داده شده در بالا) بدین صورت انجام شده که انتگرال هر تابع برابر با انتگرال تابع all zVertex (که همان نمودار نشان داده شده در شکل ۲ با برچسب ۵۰ است) شود. با توجه به این که ضخامت قطعهٔ همگن سوسوزن μμ مرود. با توجه به این که ضخامت قطعهٔ همگن سوسوزن ت مود. با توجه به این که ضخامت قطعهٔ همگن سوسوزن مروم می در است، می توان نتیجه گرفت که آمار کمینههای موضعی توابع LSF مربوط به *zVertex* های بزرگ تر از μμ ۲۰ تماماً مربوط به فوتون هایی است که در داخل میکروستون ها تولید و نهایتاً از طریق فضای خالی بین آنها به صفحهٔ پلیمر ختم شدهاند. نتایج شکل ۳ نشان می دهند که فوتون های نوری با شدهاند. نتایج شکل ۳ نشان می دهند که فوتون های نوری با داشت که در مجموع به خاطر هندسهٔ مورد استفاده و جذب



شکل ۴. توزیع فاصلهٔ شعاعی نقاط فرود فوتونهای نوری بر سطح لایهٔ پلیمر تا محور z (نمودار نقطه چین) و توزیع فاصلهٔ شعاعی نقاط تولید فوتونهای نوری در داخل مادهٔ سوسوزن (خط توپُر).

حدود ۱۰ µm در داخل مادهٔ سوسوزن (کمینهٔ نسبی نمودار نقطهچین)، به جای این که در همین بازهٔ شعاعی به صفحهٔ پلیمر برسند در فواصل شعاعی بزرگتر (به خصوص در فواصل شعاعی ۱۰ تا ۱۳» (۱۶۰) به این صفحه ختم شدهاند که البته یکی از دلایل آن نیز انکسارهای متوالی فوتون ها است که موجب پخش شــدگی و نشــر آنها داخل میکروســتون،های فراتر از میکروستون میانی میشود. براورد مطالعهٔ حاضر از درصد تعداد کل فوتونهای منتهی شده به صفحهٔ پلیمر مربعی که در داخل میکروستون مرکزی تولید شده و در انتهای آن بر سطح صفحهٔ پلیمر فرود آمدهاند (p%) به شرح جدول ۱ است. بدین ترتیب، (p) درصد از کل فوتونهای تولید شده داخل میکروستون مرکزی (که منتهی به صفحهٔ پلیمر شدهاند) به نواحی غیر از دایرهای به قطر ۹ µm واقع در مرکز این صفحه ختم شدهاند. لازم به ذكر است كه مساحت اين دايره حدود ٪ ۲۵ • • • / • مساحت کل صفحهٔ دوربین است و از اینرو نتایج این جدول تأثير قابل توجه هدايت نسبتاً مستقيم نور به صفحهٔ دوربين را که عمدتاً به واسطهٔ بازتاب کلی از سطح جانبی میکروستون است نشان می دهد.

مشترک میکروستون و صفحهٔ پلیمر میرسند در r = 0 دچار كمينهٔ نسبي شود. بررسي نتايج اين نمودار نشان ميدهد كه فاصلهٔ شعاعی بیشتر فوتونهای فرودی بر صفحهٔ پلیمر بین ۳ و ۴ μm است (لازم به ذکر است که شعاع میکروستون میانی که محور آن منطبق بر محور z است، ۴/۵ µm و دقت نشان داده شده برای اندازه گیری r در این شکل برابر با ۱ µm است). نمودار نشان داده شده به صورت خط توپُر توزيع فاصلهٔ شعاعي (تا محور z) نقطهٔ تولید فوتون های نوری در داخل مادهٔ سوسوزن را نشان میدهد. محاسبات نشان میدهند که تعداد کل فوتون های نوری تولید شده در داخل مادهٔ سوسوزن (۵۸۴۶۳۵۶۹۳) تقریباً ســه برابر تعداد فوتون،هایی اســت که از طريق هوا يا ميكروستونها به سطح سمت راست لايهٔ پليمر (نشان داده شده در شکل ۱) رسیدهاند (۲۱۴۱۱۷۳۷۳). مشاهده می شود که تعداد فوتون های نوری تولید شده در داخل مادهٔ سوسوزن در فاصلهٔ شعاعی تقریبی بین ۱۰ و µm ۱۶۰ از محور z به طور میانگین کمتر از تعداد فوتونهایی است که در همین بازهٔ فاصلهٔ شعاعی به صفحهٔ پلیمر رسیدهاند (نمودار نقطه چين). اين اتفاق به خاطر اين است كه تعداد قلبل توجهي از آمار بسیار زیاد فوتونهای تولید شده در فاصلهٔ شعاعی کمتر از

جدول ۱. درصد تعداد کل فوتونهای تولید شده داخل میکروستون مرکزی (و محتوم به رسیدن به صفحهٔ پلیمر) که به نقطهای در داخل دایرهٔ حاصل از فصل مشترک این میکروستون و صفحهٔ پلیمر برخورد کردهاند.

انرژی پرتو ایکس (keV)	p (%)
۵	۲/۵۹
١٠	۴/ • ۸
۱۵	٩/۵ •
18	11/17
١٧	11/47
٢٠	۱۲/۸۰
۴۰	17/77
۵۰	14/77

۴. نتيجه گيرې

مراجع

شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از جعبه ابزار جیانت ۴ و طراحی یک هندسهٔ ساده برای پرتونگاری پرتو ایکس مبتنی بر سوسوزنهای میکروستونی با ضخامت حدود µm ۱۰۰، نشان داد که افزایش انرژی پرتوهای ایکس اولیه تا keV ۵۰ باعث

بهبود بازده ثبت فوتونهای نوری بر روی صفحهٔ دوربین و در عین حال کاهش نسبی تارشـدگی تصـویر میشـود. در بررسـی وابستگی وضوح تصویر به عمق تولید فوتونهای نوری داخل مادهٔ سوسوزن، مشخص شد که فوتونهایی که در میلیمتر آخر مسير حركت يرتو ايكس داخل سوسوزنها توليد شدند كمترين تارشـدگی تصـویر در دوربین را به همراه داشـتند. همچنین، با مقایسهٔ نتایج قسمتهای مختلف شکل ۳، به نظر میرسد که فوتون های نوری تولید شده در عمق های کمتر از حدود ۸۰ µm به طور نسبی منجر به تارشدگی تصویر بیشتری نسبت به تصویر حاصل از همه فوتونهای نوری ثبت شده در صفحهٔ دوربین شدهاند. بررسی نتایج شکل ۴ نشان میدهد که با این که بیشتر فوتونهای نوری تقریباً بر روی محور z که همان راستا و مسیر حرکت پر تو ایکس اولیه است تولید شدهاند، بیشترین آمار نسبی ثبت فوتون های نوری بر صفحهٔ دوربین (از لحاظ فاصلهٔ نقطهٔ ثبت آنها تا راستای پرتو ایکس اولیه) در فاصلهٔ تقریبی بین ۳ و μm ۴ از امتداد برتو ایکس اولیه مشاهده خواهند شد که داخل دایرهٔ حاصل از فصل مشترک میکروستون میانی و صفحهٔ یلیمر واقع است.

- 1. R K Swank, Appl. Opt. 12 (1973) 1865.
- 2. H H Barrett and W Swindell, "*Radiolodical Imaging: The Theory of Image Formation, Detection, and Processing*", Tuscon: Academic Press, USA (1996).
- 3. Z Wang, Appl. Opt. 61 (2022) RDS1-RDS4.
- 4. F Cayouette, D Laurendeau, and C Moisan, "DETECT2000: an improved Monte-Carlo simulator for the computer aided design of photon sensing devices", Proc. SPIE 4833, Applications of Photonic Technology 5 (2003).
- 5. L Wang, S L Jacques, and L Zheng, Comput. Methods Programs Biomed. 47 (1995) 131.
- 6. A A Leino, A Pulkkinen, and T Tarvainen, OSA Contin. 2 (2019) 957.
- 7. S Agostinelli, et al., Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A 506 (2003) 250.
- 8. A Badano, and M J Flynn, "Proceedings of the International Display Research Conference", Toronto, Canada, (1997).
- 9. H Moeini and M Mokari, Med. Phys. 49 (2022) 4823.
- 10. H Moeini, et al., Int. J. Radiat. Biol. 96 (2020) 767.
- 11. M Mokari, et al., Phys. Med. Biol. 63 (2018) 175003.
- 12. M Mokari, H Moeini, and M Soleimani, Int. J. Radiat. Biol. 97 (2021) 208.
- 13. A L N Stevels and A D M Schrama de Pauw, Philips Res. Rep. 29 (1974) 353.
- 14. W F Berg, Appl. Opt. 8 (1969) 2407.
- 15. V Nagarkar, et al., "X-Ray and Ultraviolet Sensors and Applications", San Diego, USA, (1995).
- 16. S Derenzo, and W Moses, "Crystal 2000 International Workshop on Heavy Scintillators for Scientific and Industrial Applications", Chamonix, France, (1992).
- 17. L Latacz and P Nowak, Opt. Appl. XXVIII (1998)183.